
	<p><b>BSG0810NDIATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSG0810NDIATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 25V 19A/39A 8TISON</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSG0810NDIATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



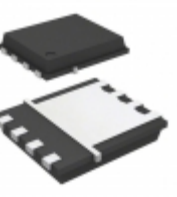



Spezifikationen

Teilenummer	BSG0810NDIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 19A/39A 8TISON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TISON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 20A, 10V
Leistung - max	2.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 155°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.4nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 4.5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A, 39A

BSG0810NDIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSG0810NDIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSG0810NDIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSG0810NDIATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>BSG0813ND1</b> INFINEON INFINEON TISON8</p>	 <p><b>BSG0812NDATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 8TISON</p>	 <p><b>BSG0811NDATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 25V 19A/41A 8TISON</p>	 <p><b>BSG0812ND</b> INFINEON BSG0812ND INFINEON</p>
 <p><b>SIZ998DT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR</p>	 <p><b>BSG251</b> BSG BSG TO92</p>	 <p><b>BSG0811ND</b> INFINEON BSG0811ND INFINEON</p>	 <p><b>BSG0813NDI</b> INFINEON BSG0813NDI INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSG0810NDIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSG0810NDIATMA1 Datenblatt	BSG0810NDIATMA1-Datenblätter	BSG0810NDIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSG0810NDIATMA1
BSG0810NDIATMA1 Electronic	BSG0810NDIATMA1-Komponenten	BSG0810NDIATMA1-Verteiler	BSG0810NDIATMA1-Bild	BSG0810NDIATMA1-Teil
BSG0810NDIATMA1 Preis	BSG0810NDIATMA1 Hersteller	BSG0810NDIATMA1 Bild	BSG0810NDIATMA1 Aktie	BSG0810NDIATMA1 Inventar
BSG0810NDIATMA1 Neu	BSG0810NDIATMA1 Original	BSG0810NDIATMA1 garantiert	BSG0810NDIATMA1 RFQ	BSG0810NDIATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited